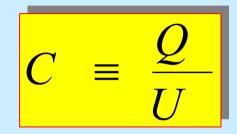
# §7.5 电容器及电容

电容是表征导体储电能力的物理量

一. 孤立导体的电容

孤立导体所带的电荷 Q 与其电势 U 的比值是一个不变值

SI 单位:法拉 F  $\mu F, PF$ 



导体的电容只与导体的尺寸、形状等几何因素和介质有关,与带电量多少无关 固有的容电本领

例 求真空中孤立导体球的电容(如图)

解: 设球带电为Q 导体球电势

$$U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$
 导体球电容  $C = \frac{Q}{U} = 4\pi\varepsilon_0 R$ 

一欲得到 1F 的电容 孤立导体球的半径 R?

由孤立导体球电容公式知

$$R = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9 m \approx 10^3 R_E$$



由静电屏蔽--导体壳内部的场只由腔内的电量 Q

和几何条件及介质决定(相当于孤立)

$$C = \frac{Q}{\Delta U}$$

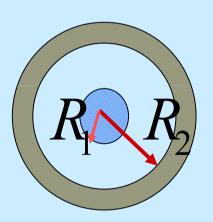
ΔU 球壳与腔内带电体电势差

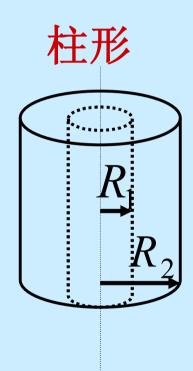
内表面

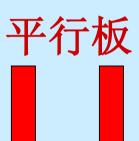
电容的计算
$$Q \longrightarrow \vec{E} \longrightarrow \Delta U_{AB} \longrightarrow C = \frac{Q}{\Lambda U}$$

# 三、典型的电容器

# 球形







# 例1 求球形电容器的电容

解:

设内、外球壳带电量 分别为+Q和-Q

则两球壳间的电场为: 
$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

两球壳间的电势差为:

$$\Delta U = \int_{R_A}^{R_B} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \int_{R_A}^{R_B} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left( \frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right)$$

球形电容器的电容为:

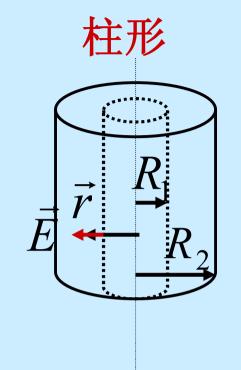
$$C = \frac{Q}{\Delta U} = \frac{4\pi\varepsilon_0 R_A R_B}{R_B - R_A}$$

# 例2 求柱形电容器单位长度的电容

解: 设单位长度带电量为  $\lambda$ 

$$R < r < R_2$$
 
$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

$$\Delta U = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



柱形电容器的电容为:

$$C = \frac{\lambda}{\Delta U} = \frac{2 \pi \varepsilon_0}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

# 例3 平行板电容器的电容

解: 令两板带电量分别为+Q和-Q

则两板间的场强为:

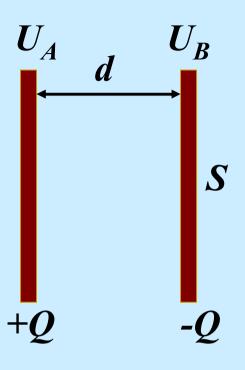
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{S\varepsilon_0}$$

两板间的电势差为:

$$\Delta U = \int_{A}^{B} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{S\varepsilon_{0}} \cdot d = \frac{Qd}{\varepsilon_{0}S}$$

电容为:

$$C = \frac{Q}{\Delta U} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$



# 四. 有介质时的电容器的电容

$$C = C_0 \varepsilon_r$$

无介质时 
$$Q_0 \to E_0 \to \Delta U_0 \to C_0 = \frac{Q_0}{\Delta U_0}$$

有介质时 
$$E = \frac{E_0}{\varepsilon_r} \rightarrow \Delta U = \frac{\Delta U_0}{\varepsilon_r} \rightarrow C = \frac{Q_0}{\Delta U}$$

$$= \frac{Q_0}{\Delta U_0} \varepsilon_r$$

$$\varepsilon_r = \frac{C}{C_0}$$
 电容率  $= C_0 \varepsilon_r$ 

### 五、电容器的串联与并联

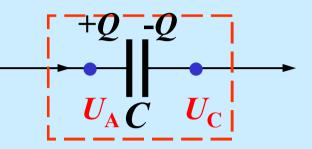
# 1、串联 [\_\_\_\_\_\_

$$U_A - U_B = \frac{Q}{C_1}$$

$$U_B - U_C = \frac{Q}{C_2}$$

$$U_A - U_C = Q \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

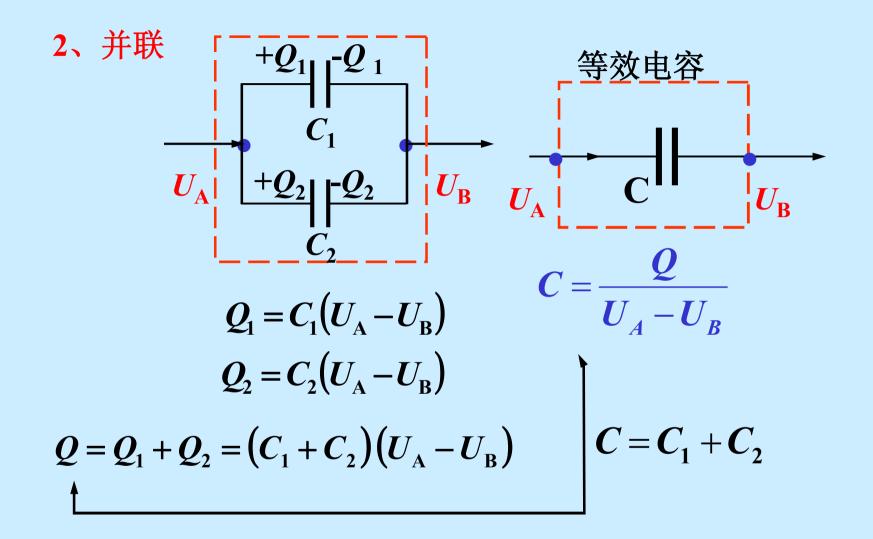
一般n 个电容器串 联的等效电容为 等效电容



$$C = \frac{Q}{U_A - U_C}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$\frac{1}{C} = \sum_{i}^{n} \frac{1}{C_{i}}$$

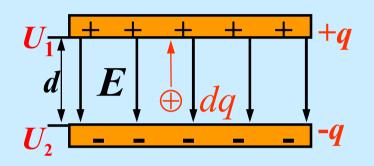


一般n个电容器并 联的等效电容为

$$C = \sum_{i}^{n} C_{i}$$

# § 7.6 静电场的能量

### 一、电容器中的静电能



电容器充电=外力不断地把电 荷元dq从负极板搬运到正极板。

=电场力作负功

$$dA = (U_1 - U_2)dq = \frac{q}{C}dq$$

极板上电荷从 $0 \sim Q$ ,外力作功

根据能量守恒定律,外力作功 A=电容器中储存的静电能W

$$A = \int_0^Q \frac{q}{C} \, \mathrm{d}q = \frac{Q^2}{2C}$$

$$W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2} = \frac{QU}{2}$$

$$CU = Q$$

### 二、电场能量和能量密度

$$W_{e} = \frac{QU}{2}$$

$$U = Ed$$

$$Q = \sigma S$$

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

$$Sd = V$$

$$W_e = \frac{\varepsilon}{2} E^2 V$$

$$w_e = \frac{\varepsilon E^2}{2}$$

各向同性介质

$$w_e = \frac{DE}{2} = \frac{D^2}{2\varepsilon}$$

真空中

$$w_{eo} = \frac{\varepsilon_o E^2}{2}$$

### 能量密度

$$: \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r > \varepsilon_0$$

电场强度相同

$$\therefore w_e > w_{e o}$$

介质极化过程也吸收并储存了能量。

具有普遍意义,不只对均匀电场成立,表示任意电场的能量密度。

### 电场储存有能量

任意场中存储的能量为

$$W_{e} = \int_{V} w_{e} dV$$

例:一均匀带电球体,半径为R,带电量为q。求带电球体

的静电能。(不考虑球体的极化)

解、场强分布

$$E_1 = \frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} \qquad (r \le R)$$

$$E_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad (r \ge R)$$

$$W = \int w_e dV = \int_{r < R} w_1 dV + \int_{r > R} w_2 dV$$

$$= \int_0^R \frac{\varepsilon_0 E_1^2}{2} 4\pi r^2 dr + \int_R^\infty \frac{\varepsilon_0 E_2^2}{2} 4\pi r^2 dr$$

$$= \int_0^R \frac{\varepsilon_0}{2} \left( \frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} \right)^2 4\pi r^2 dr + \int_R^\infty \frac{\varepsilon_0}{2} \left( \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{3q^2}{20\pi\varepsilon_0 R}$$

$$=\frac{3q^2}{20\pi\varepsilon_0 R}$$

# 例 导体球的电场能(相当于球面)

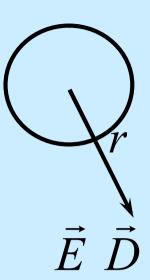
$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$D = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

$$w_{eo} = \frac{\varepsilon_o E^2}{2} = \frac{1}{2} E \cdot D$$

$$W_{e} = \int_{R}^{\infty} w_{e} dV = \int_{R}^{\infty} \frac{Q^{2}}{32\pi^{2} \varepsilon_{0} r^{4}} 4\pi r^{2} dr$$

$$W_{e} = \frac{Q^{2}}{8\pi \varepsilon_{0} R}$$



例、空气平板电容器,极板面积为S,间距为d,今以厚度为d'的铜板平行地插入电容器内。

- 1、计算插入铜板后的电容器电容
- 2、铜板位置对结果是否有影响?
- 3、充电到电势差为 *U* 后 断开电源,抽出铜板作功多少?

解: 1、铜板插入前的电容  $C = \frac{\mathcal{E}_0 S}{d}$  设极板带电为  $\pm q$  铜板 内 E = 0 外  $E = \frac{\sigma}{d} = \frac{q}{d}$ 

铜板内
$$E = 0$$
 外 $E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon_0 s}$ 

$$U_{A} - U_{B} = E_{0}d_{1} + E_{0}d_{2} = E_{0}(d - d') = \frac{q(d - d')}{\varepsilon_{0}S}$$

$$C' = \frac{q}{U_A - U_B} = \frac{\varepsilon_0 s}{d - d'}$$
 或者

或者 
$$\frac{1}{C'} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

3、充电到电势差为U后断开电源,抽出铜板作功多少?电容器充电到电势差为U时,极板带电量为 Q = C'U

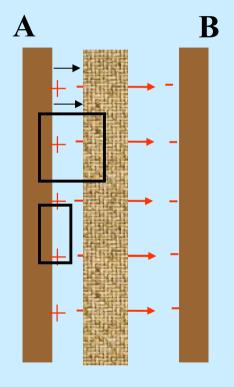
储能 
$$\longrightarrow W' = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C'}$$
  $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$ 

切断电源抽出铜板电容器所储能量为

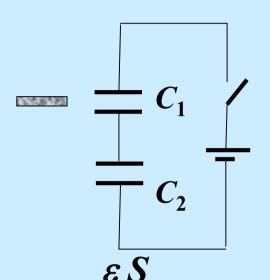
$$A = W - W' = \frac{Q^2}{2} \left( \frac{1}{C} - \frac{1}{C'} \right) = \frac{Q^2}{2} \frac{d'}{\varepsilon_0 s}$$
$$= \frac{1}{2} \left( \frac{\varepsilon_0 s}{d - d'} \right)^2 U^2 \frac{d'}{\varepsilon_0 s} = \frac{\varepsilon_0 s U^2 d'}{2(d - d')^2}$$

外力做功转换为电场能量

如果插入的是介质平板,情况如何?  $C^{"} > C$ 



# 分析两电容器插入介质条前后电量、电压、能量的变化



$$\frac{1}{C} = \sum_{i}^{n} \frac{1}{C_{i}}$$

串联 Q1=Q2

$$U_1+U_2=U$$

- 1. 插入介质 条过程中开关始终闭合
- 2. 充电后,开关打开,再插入介质条

$$C = \frac{Q}{U}$$

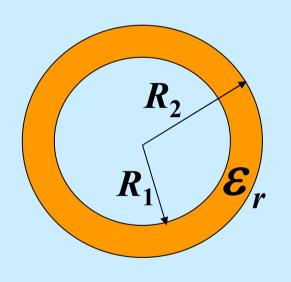
$$W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2} = \frac{QU}{2}$$

开关合上: 电势不变。

开关断开: 电量不变。

例 1.一球形电容器,内球壳半径为 $R_1$ ,外球壳半径为  $R_2$ , 两球壳间充满了相对介电常数为  $\varepsilon_{x}$  的各向同性的 均匀电介质。设两球壳间电势差为 $U_{I}$ 

求: 1) 电容器的电容; 2) 电容器储存的能量



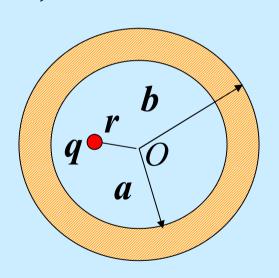
$$C = \frac{Q}{U} = \frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

$$W = \int w_e dV = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R_1 R_2 U_1^2}{R_2 - R_1}$$
  
或:  $W = \frac{1}{2}CU^2 = ...$ 

或: 
$$W = \frac{1}{2}CU^2 = .$$

例2 如图所示。一内半径为a,外半径为b的金属球壳体,带有电量Q,在球壳空腔内距离球心r处有点电荷q.设无限远处为电势零点,试求:

- 1) 球壳内、外表面上的电荷;
- 2) 球心 0点处,由球壳内表面上电荷产生的电势;
- 3) 球心 0点处的总电势。



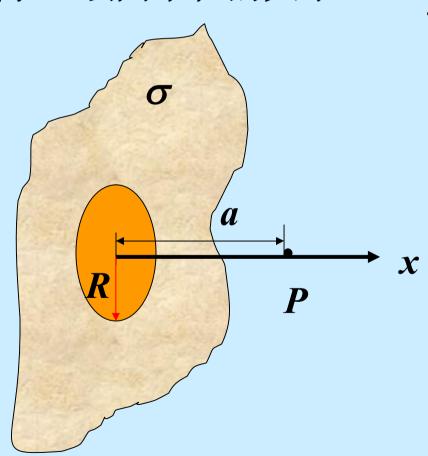
1)内表面 - q 不均匀

外表面 Q+q 均匀

2) 
$$U_{-q} = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a}$$
3) 
$$U_0 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a} + \frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 b}$$

例3 一电荷面密度为  $\sigma$  的"无限大"平面,在距离平面 a 米远处的一点 P 的场强大小的一半是由平面上的一个半径为 R 的圆面积范围内的电荷所产生的。

试求:该圆半径的大小。



思路: 
$$\overrightarrow{E}_P = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{x}$$
盘:  $E_{\underline{a}_P} = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}$ 

$$E_{\Xi} = \int_{0}^{R} dE_{\Xi}$$

$$dE_{\Xi} = \frac{\frac{1}{2} a \cdot dq}{4\pi \varepsilon_{0} (a^{2} + r^{2})^{\frac{3}{2}}}$$

$$dq = 2\pi r \cdot dr \cdot \sigma$$

$$R = \sqrt{2}a$$

例4 如图所示,在电矩为 P 的电偶极子的电场中,将一电量为  $q_0$  的点电荷从 A 点沿半径为 R 的圆弧(圆心与电偶极子中心重合,R>> l) 移到 B 点,求此过程中电场力所所做的功。

保守力场,做功仅与初、末位置有关

$$A = q_0(U_A - U_B)$$

$$U_{A} = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_{0}(R - \frac{l}{2})} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}(R + \frac{l}{2})} \approx - \frac{P}{4\pi\varepsilon_{0}(R - \frac{l}{2})}$$

$$U_{B} \approx \frac{P}{4\pi\varepsilon_{0}R^{2}} \qquad R >> l \quad P = ql$$

$$A = -\frac{q_{0}P}{R^{2}}$$